

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Научно-исследовательского
института физики полупроводников
и микроэлектроники при

Национальном университете
Узбекистана им. Мирзо Улугбека

_____ Ш. Утамурадова

« ____ » _____ 2019г.

**Правила оформления статей для
научного журнала “Физика полупроводников и микроэлектроника”**

1. Представляемые рукописи должны соответствовать тематике научного журнала “Физика полупроводников и микроэлектроника” (далее - Журнал) по следующим направлениям:

- **Физика полупроводников;**
- **Полупроводниковая микроэлектроника;**
- **Полупроводниковое материаловедение;**
- **Радиационная физика полупроводников**

Правила подготовки рукописей ориентированы на компьютерный набор.

2. В Журнале **публикуются** авторские материалы:

- оригинальные статьи, содержащие результаты теоретических и прикладных исследований;
- научные обзоры и аналитические материалы.

Не публикуются:

- авторские материалы, ранее опубликованные в других изданиях;
- статьи, не содержащие новой информации, по сравнению с ранее опубликованными результатами, либо содержащие фактические, исторические или иные ошибки, которые не могут быть исправлены, а также статьи, содержащие утверждения и гипотезы, прямо противоречащие установленным научным фактам;
- литературно-художественные и публицистические произведения любого содержания, в том числе - на научную тему;
- любую информацию и объявления, не имеющие непосредственного отношения к научной деятельности;
- материалы, содержащие сведения, которые составляют государственную либо коммерческую тайну, как это определяется действующим законодательством Республики Узбекистан и ведомственными нормативными актами, договорами и т.д.;
- материалы, содержащие пропаганду негативного характера против действующей политической системы Республики Узбекистан, оскорбления, клевету или заведомо ложные сведения в отношении граждан и организаций.

3. В статье по порядку приводится следующая информация:

- УДК;
- название статьи;
- фамилии авторов, название организации, где была выполнена работа, а также адрес, электронная почта и контактный телефон авторов, с которыми редакция связывается при необходимости;
- аннотации на русском и английском языках одинакового содержания объемом 7-10 строк, но не менее трех предложений;
- ключевые слова (словосочетания), отражающие специфику статьи не более 10 слов на русском и английском языках;
- текст статьи;

-список использованной литературы (с оригинальными названиями публикаций и с транслитерацией названий публикаций, приведенных не в романском алфавите)

4. Статьи, содержащие результаты работ, проведенных в учреждении, должны обязательно указать название учреждения. Если коллектив авторов включает сотрудников разных учреждений, то следует указать место работы каждого автора.

5. Журнал принимает статьи объемом не менее 3 и не более 5 стр., включая не более 4 рисунков.

6. Сканированная копия статьи, подписанная всеми авторами, направляется в редакцию по электронной почте и должна сопровождаться экспертным заключением (только для авторов из РУз).

7. При направлении статьи в редакцию все рисунки направляются отдельными файлами в формате .jpg или .bmp. Рисунки выполняются в графическом редакторе. Сканированные рисунки не допускаются.

8. Электронные версии статей, подготовленные в формате Word for Windows (не ниже версии 2007) с расширением .docx, присылаются по электронной почте ispm_uz@mail.ru, (director@ispm.uz в копии). Текст следует набирать шрифтом Times New Roman 12pt, интервал 1,5. Поля: слева 3 см, сверху и внизу по 2.5 см, справа 2 см; текст выравнивается по ширине, а формулы - с использованием встроенного редактора формул (в редакторе Word перейти на вкладку «Вставка», затем на вкладку «Формула»). Уменьшенный шрифт (петит) в представляемой рукописи не используется нигде. Использование сносок не допускается.

В целях упорядочения присылаемой по электронной почте информации, файл с текстом статьи, а также графические файлы следует поместить в одну папку, которая архивируется в файл в формате ZIP или RAR. Название этого файла именуется фамилией первого автора.

9. Рекомендуются придерживаться следующей структуры текста статьи:

- Введение;
- Область исследования;
- Методика эксперимента;
- Экспериментальные результаты;
- Обсуждение результатов;
- Заключение.

10. Не следует употреблять сокращений (аббревиатур) в заглавии статьи и аннотации. Не начать заглавие статьи с артикля, если статья на английском языке. В тексте статьи все сокращения должны быть расшифрованы при первом упоминании, даже если употребляемое

сокращение является общепринятым, например, вольт-амперная характеристика (ВАХ).

11. Список литературы должен быть составлен в порядке упоминания. В статье должно быть не менее 10 ссылок на литературу, опубликованную в течение последних 10-15 лет в рецензируемых изданиях. В тексте дается ссылка арабской цифрой в квадратных скобках: [1,2]. В списке литературы перечисляются фамилии всех авторов. Список литературы оформляется следующим образом.

Статья в журнале: И.О. Фамилии авторов, Название журнала том, выпуск (или номер), страница, год (в скобках). Например, J.C. Slater, Phys. Rev. 23, 488 (1954).

Книга: И.О. Фамилии авторов. Название книги, том, затем в скобках даются город, издательство, год издания. Например, С. Kittel. Introduction to solid state physics (New York, John Wiley&Sons, Inc., 1956).

Статья или тезис в сборнике: И.О. Фамилии авторов. В сб.: Название сборника (город, издательство, год издания или место и время проведения конференции), начальная страница статьи или тезиса. Например:

1. A.E. Carlsson. In: Solid State Physics. Advances in Research and Applications, Eds. D. Turnbull, H. Ehrenreich (New York, Academic Press, 1990), p.1.

2. Z.M. Khakimov. In: Book of Abstracts of Europhysics Conference on Computational Physics (Aachen, Germany, 5-8 September, 2001), p. A138.

12. Список литературы не в романском алфавите должен быть приведен в транслитерированной форме. Транслитерацию рекомендуется выполнять с помощью on-line программы <https://www.itranslit.com>. При этом транслитерированный список должен содержать также названия публикаций, оригиналы которых приводятся в романском алфавите. Транслитерированный список приводится отдельно и имеет название REFERENCES.

Пример транслитерированного названия публикации:

Оригинальное название:

Д. С. Андреев, В. С. Варганова, П. Е. Хакуашев, И. В. Чинарева, А. И. Дирочка. Уменьшение времени восстановления чувствительности в $p-i-n$ -фотодиодах на основе InGaAs/InP после воздействия мощных импульсных фоновых засветок. Прикладная физика, 2015, № 6. С. 70-73.

Транслитерированное название:

D. S. Andreev, V. S. Varganova, P. E. Khakuashev, I. V. Chinareva, A. I. Dirochka. *Umen'shenie vremeni vosstanovleniya chuvstvitel'nosti v $p-i-n$ -fotodiodakh na osnove InGaAs/InP posle vozdeystviya moshchnykh impul'snykh fonovykh zasvetok* [Reducing the recovery time of sensitivity in p-i-n-photodiodes based on InGaAs/InP after exposure to high-power pulsed backlights]. 2015, *Prikladnaya fizika* [Applied Physics], no. 6. pp. 70-73. (In Russ.).

(см. Правила оформления Списка литературы и References)

13. Издательство имеет право вносить необходимую корректуру в рукописью: аннотацию, ключевые слова список литературы без согласования с автором, а также тексты переводов на английский язык.

14. Для опубликования в журнале принимаются статьи в соответствии с тематикой журнала.

Примечание. Поступившие статьи авторов (соавторов) в редакцию Журнала проверяется через систему «Антиплагиат». При отправке статьи на публикацию в научный журнал “Физика полупроводников и микроэлектроника” автор делегирует редакции Журнала права на публикацию статьи, а также гарантирует оригинальность содержания статьи. Если материалы статьи нарушают авторские права третьих лиц, ответственность лежит на авторе статьи. Автор несет персональную ответственность за содержание и оформление предоставляемых к публикации материалов.

Редакция не выплачивает авторам денежные вознаграждения за предоставленные для публикации материалов.

Главный редактор

Утамурадова Ш.Б.